

おすすめ! 新商品



ロームの新省エネデバイス登場!

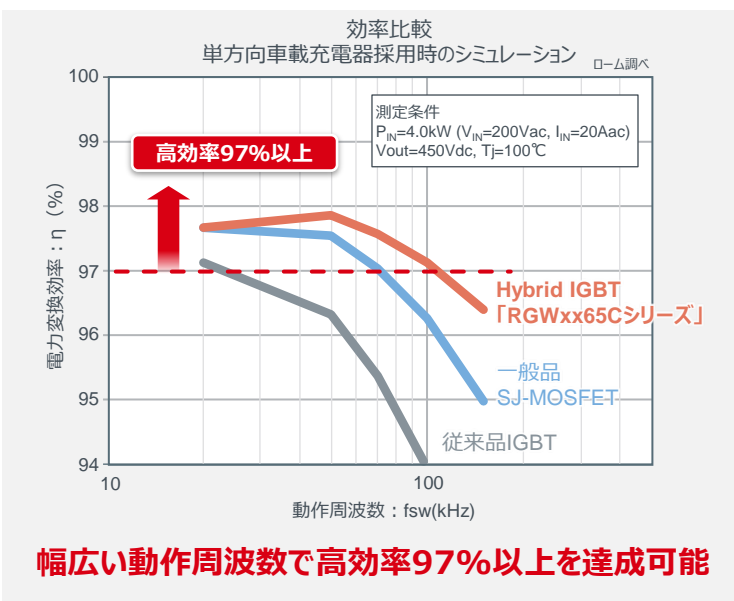
SiCショットキーバリアダイオード内蔵 Hybrid IGBT

RGWxx65Cシリーズ (AEC-Q101準拠)

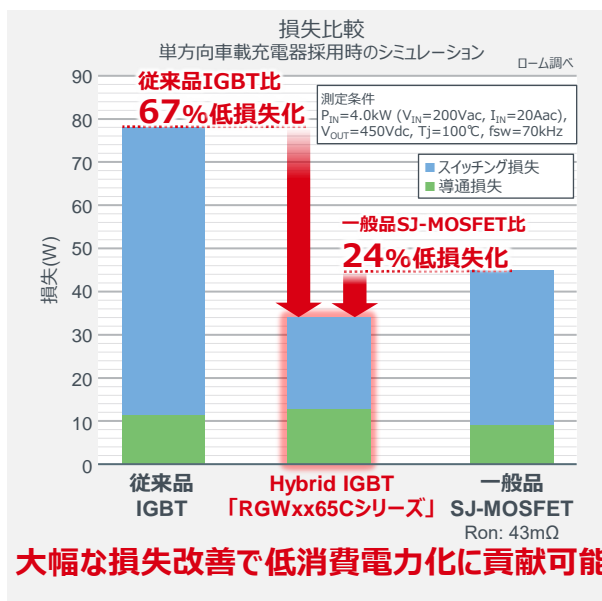
- ・従来品IGBTより大幅な高効率を実現
- ・高速IGBT+SiCショットキーバリアダイオード (SiC SBD) でターンオン損失大幅削減
- ・低飽和電圧でさらに高効率 $V_{CE(sat)} = 1.5V$



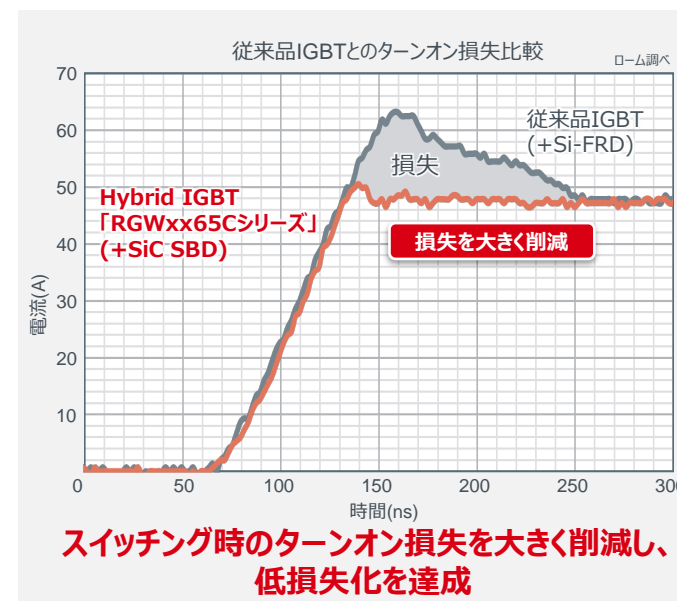
■ 効率改善



■ 損失改善

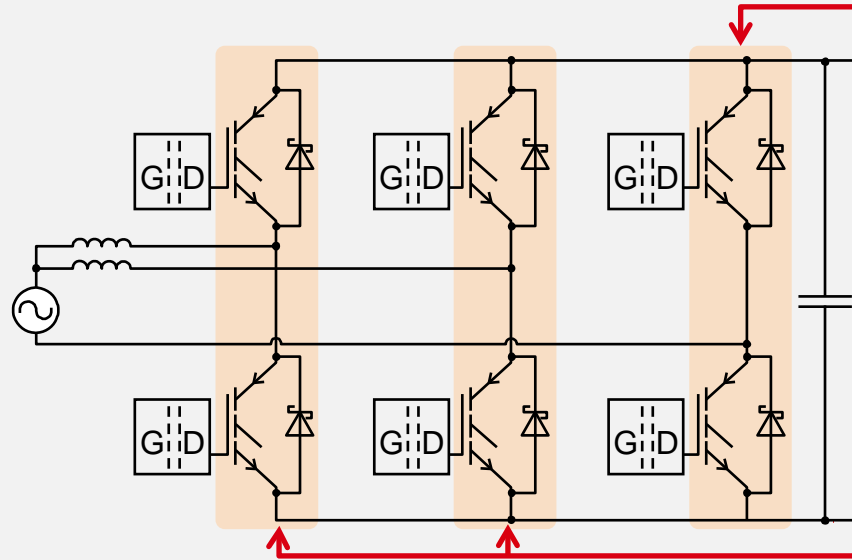


■ SiC SBD内蔵によりリカバリ特性を改善



■ インターリーブトームポールPFC用パワーデバイス（双方向車載充電器）

■ アプリケーション



整流側デバイス 650Vクラス～

コスト重視/IGBT : RGWxxx65Eシリーズ

整流用途のため、スイッチング特性は求められない

SW側デバイス 650Vクラス～

効率重視/SiC MOSFET : SCT3xxxALシリーズ

効率&コスト重視 : Hybrid IGBT : RGWxxx65Cシリーズ

SW側パワーデバイスで効率アップに最も必要な特性

- ・SW動作時のダイオードのリカバリ特性
- ・導通損失が低いこと (Ron)

SiC SBDによる高速リカバリがPFC回路の高効率化に最適

車載充電器
(オンボードチャージャー)

車載DC/DCコンバータ

太陽光発電インバータ
(パワーコンディショナー)

無停電電源装置 (UPS)

■ ラインアップ

端子挿入タイプ

品名	耐圧 V _{CES} (V)	コレクタ電流 I _C (A) T _C =100°C	導通損失 V _{CE(sat)} Typ (V)	還流 ダイオード	I _F (A) T _C =100°C		AEC-Q101 準拠	パッケージ
					I _F (A) T _C =100°C	V _F (V)		
New RGW60TS65CHR Data Sheet	650	30	1.5	SiC SBD	20	1.35	YES	TO-247N
New RGW80TS65CHR Data Sheet		40	1.5					
New RGW00TS65CHR Data Sheet		50	1.5					

パッケージはJEDEC表記です。

面実装タイプ

品名	耐圧 V _{CES} (V)	コレクタ電流 I _C (A) T _C =100°C	導通損失 V _{CE(sat)} Typ (V)	還流 ダイオード	I _F (A) T _C =100°C		V _F (V)	AEC-Q101 準拠	パッケージ
					I _F (A) T _C =100°C	V _F (V)			
☆ RGW40NL65CHRB	650	20	1.5	SiC SBD	12	1.35	YES	TO-263L (LPDL)	
☆ RGW50NL65CHRB		25	1.5						
☆ RGW60NL65CHRB		30	1.5						

パッケージはJEDEC表記です。()内はROHMパッケージを示します。 ☆：開発中



ローム株式会社

〒615-8585 京都市右京区西院満崎町21

www.rohm.co.jp

本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。本資料に記載されております製品および技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に該当する製品または技術を輸出する場合、または国外に提供する場合、は、同法に基づき許可が必要です。

ローム商品のご用命は

本資料の記載内容は 2021 年 7 月 1 日現在のものです。